

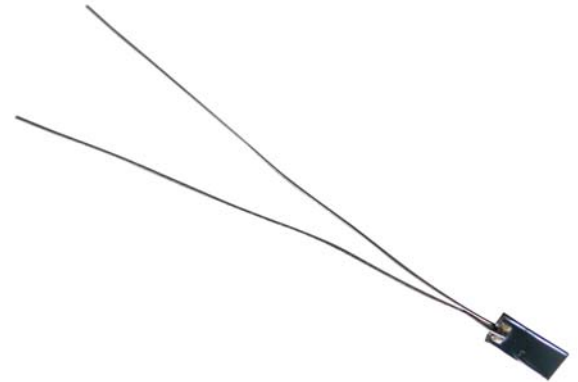
PR7.4-6 Ch

PR7.4-6 Dr

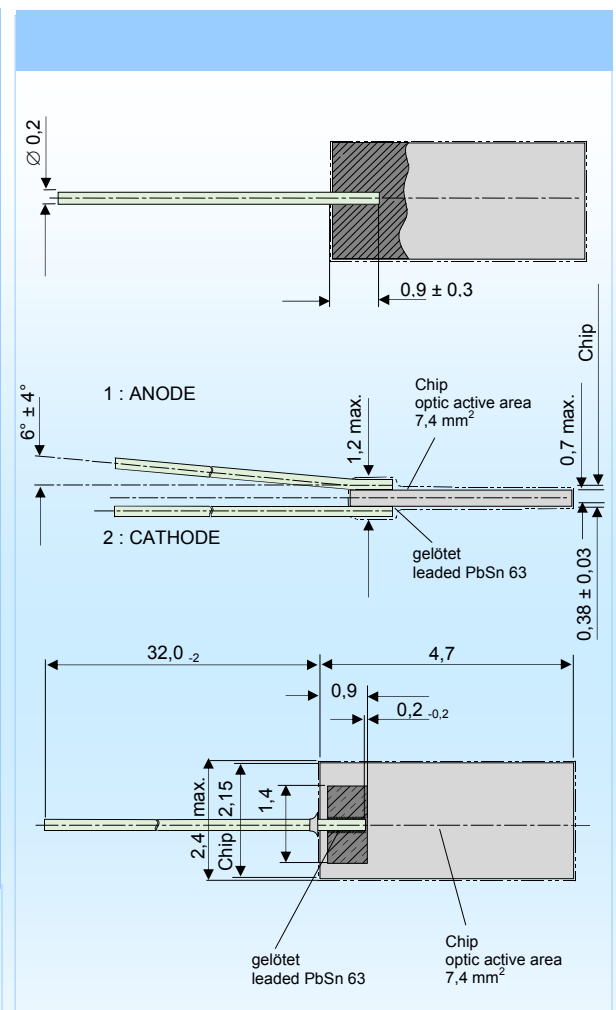
Silizium PIN Fotodiode

Besonderheiten:

sehr geringes Dunkelstromniveau
geeignet für Anwendungen von 400 nm bis 1100 nm
als Chip oder Chip bedrahtet

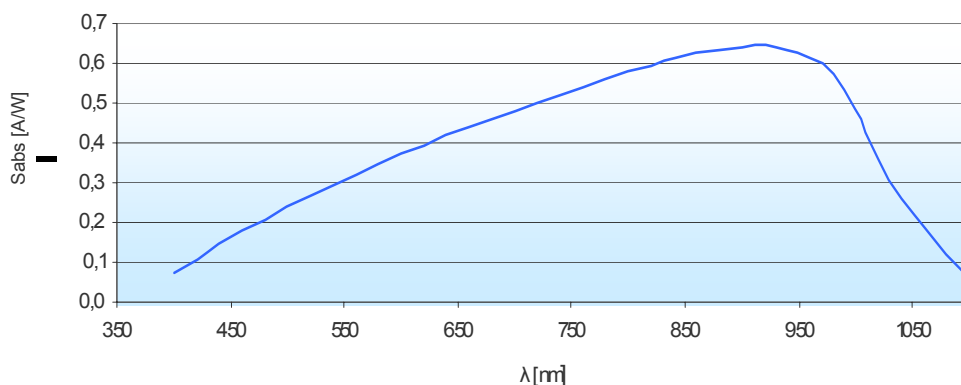


Parameters:	PR7.4-6 Ch PR7.4-6 Dr
Aktive Fläche	7,4 mm ²
Halbwinkel	+ 60 Grad
Dunkelstrom (@ 10 V)	max. 5 nA, typ. 0,5 nA
Max. Sperrspannung	15 V
Verlustleistung (@ 25 °C)	150 mW
Fotoempfindlichkeit (@ 5 V)	typ. 80 nA/lx min. 55 nA/lx
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit	920 nm
Spektrale Empfindlichkeit (λ = 900 nm)	min. 0,60 A/W
Quantenausbeute (λ = 900 nm)	0,80 electrons/photon
Leerlaufspannung (E _v = 1000 lx)	typ. 370 mV min. 330 mV
Kurzschlussstrom (E _v = 1000 lx)	typ. 70 μA
Anstiegs-/Abfallzeit d. Fotostroms ¹⁾ (V _R = 10 V, λ = 850 nm, R _L = 50 Ω)	40 ns
Flussspannung (I _F = 10 mA, E = 0)	0,75 V
Kapazität (V _R = 0 V, f _m = 1 MHz, E = 0)	65 pF
Temperaturkoeffizient für I _{sc}	0,15 %/K
Rauschäquivalente Strahlungsleistung (V _R = 20 V, λ = 850 nm)	2 x 10 ⁻¹⁴ W/Hz
1) Fotodiode überstrahlt	



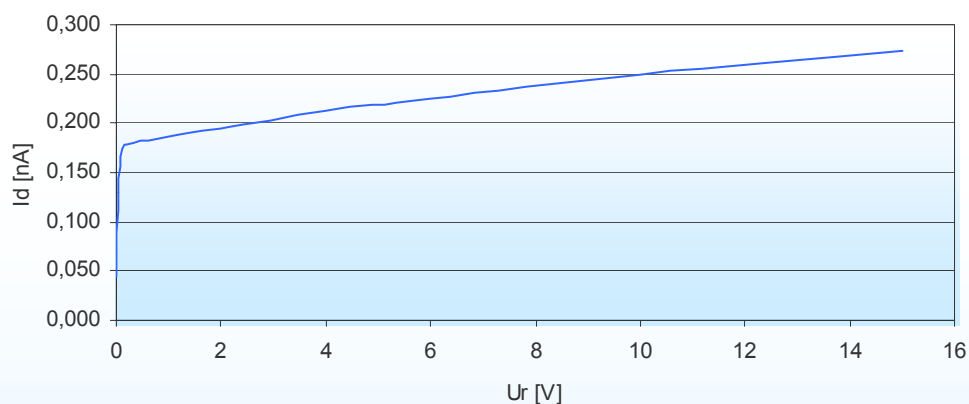
Absolute spektrale Empfindlichkeit

$$S_{abs} = f(\lambda)$$



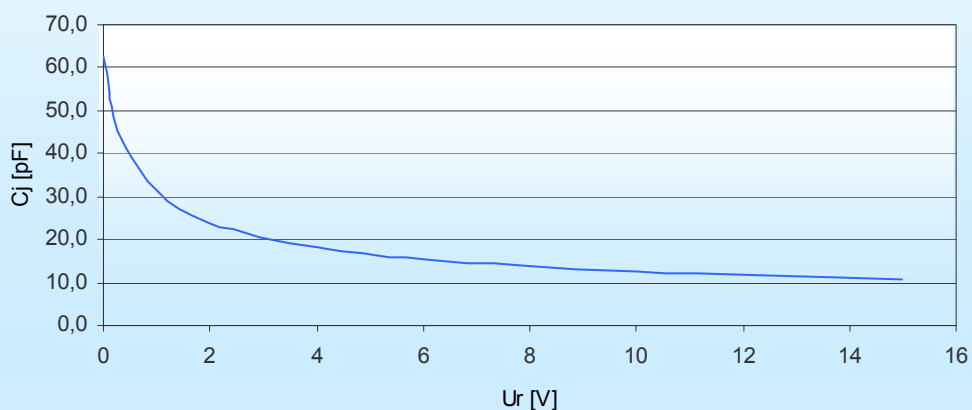
Dunkelstromkennlinie

$$I_D = f(U_R)$$



Sperrschichtkapazität

$$C_j = f(U_R)$$



Germany :

Silicon Sensor GmbH

Ostendstr. 1
12459 Berlin
Germany
Phone: +49 (0)30-63 99 23 10
Fax: +49 (0)30-63 99 23 33
E-Mail: sales@silicon-sensor.de

International Sales:

Silicon Sensor GmbH

U.K. Office
35 Orchard Close
Stanstead Abbots, Ware
Hertfordshire SG 12 8 AH
Phone/Fax: +44 (0)1920/87 20 90
E-Mail: p.nash@silicon-sensor.com

U.S.A. :

Pacific Silicon Sensor, Inc.

5700 Corsa Avenue #105
Westlake Village
CA 91362 USA
Phone: +1-818-706-3400
Fax: +1-818-889-7053
E-Mail: sales@pacific-sensor.com